

IHM-B モジュール 高速トレンチ/フィールドストップ IGBT3 とエミッターコントロール 3 ダイオード内蔵

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 3300\text{ V}$
 - $I_{Cnom} = 1200\text{ A} / I_{CRM} = 2400\text{ A}$
 - 優れたロバスト性
 - 高い DC 電圧での安定性
 - 高い短絡耐量
 - 低スイッチング損失
 - 低 V_{CESat} 飽和電圧
 - $T_{vjop} = 150^{\circ}\text{C}$
 - 正温度特性を持った V_{CESat} 飽和電圧
- 機械的特性
 - サーマルサイクル耐量を増加する AlSiC ベースプレート
 - CTI(比較トラッキング指数) > 600 のモジュールパッケージ
 - IHM Bハウジング
 - 絶縁されたベースプレート



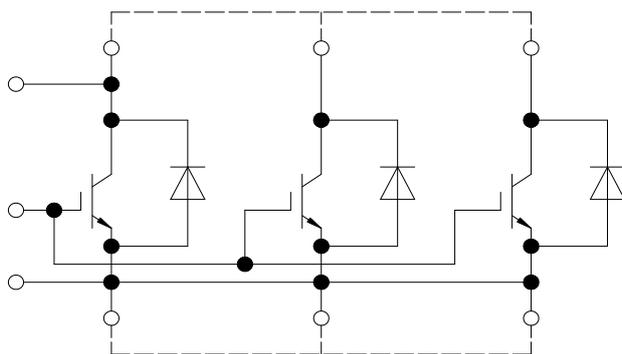
可能性のある用途

- チョッパアプリケーション
- 中電圧コンバータ
- モーター駆動
- 電鉄駆動
- UPS システム
- 風力タービン

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細



external connection
(to be done)

目次

	詳細	1
	特徴	1
	可能性のある用途	1
	製品検証	1
	目次	2
1	ハウジング	3
2	IGBT- インバータ	3
3	Diode、インバータ	5
4	特性図	7
5	回路図	10
6	パッケージ外形図	11
7	モジュールラベルコード	12
	改訂履歴	13
	Disclaimer	14

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	6.0	kV
部分放電電圧	V_{isol}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $Q_{PD} \leq 10 \text{ pC}$	2.6	kV
DC スタビリティ	$V_{CE(D)}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, 100 Fit	2100	V
ベースプレート材質			AlSiC	
沿面距離	d_{Creep}	連絡方法 - ヒートシンク	32.2	mm
空間距離	d_{Clear}	連絡方法 - ヒートシンク	19.1	mm
相対トラッキング指数	CTI		>600	

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{SCE}			6		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, /スイッチ		0.12		mΩ
保存温度	T_{stg}		-40		150	°C
取り付けネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング	M6, 取り付けネジ	4.25	5.75	Nm
主端子ネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング	M4, 取り付けネジ	1.8	2.1	Nm
			M8, 取り付けネジ	8	10	
質量	G			1200		g

2 IGBT- インバータ

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位	
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}		$T_{vj} = -40^\circ\text{C}$	3300	V
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	3300	
連続 DC コレクタ電流	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 150^\circ\text{C}$	$T_C = 95^\circ\text{C}$	1200	A
繰り返しピークコレクタ電流	I_{CRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$		2400	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	V_{GES}			±20	V

表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 1200\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		2.70	3.20	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		3.15	3.60	
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		3.30		
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	V_{GEth}	$I_C = 54\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		5.20	5.80	6.40	V
ゲート電荷量	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CE} = 1800\text{ V}$			32		μC
内蔵ゲート抵抗	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$			0.44		Ω
入力容量	C_{ies}	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			210		nF
帰還容量	C_{res}	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			4.5		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 3300\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$			5	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$				400	nA
ターンオン遅延時間(誘導負荷)	t_{don}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.62\text{ }\Omega, C_{GE} = 220\text{ nF}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		0.350		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		0.380		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		0.380		
ターンオン上昇時間(誘導負荷)	t_r	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.62\text{ }\Omega, C_{GE} = 220\text{ nF}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		0.350		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		0.380		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		0.380		
ターンオフ遅延時間(誘導負荷)	t_{doff}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 2.4\text{ }\Omega, C_{GE} = 220\text{ nF}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		3.000		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		3.200		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		3.200		
ターンオフ下降時間(誘導負荷)	t_f	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 2.4\text{ }\Omega, C_{GE} = 220\text{ nF}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		0.300		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		0.350		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		0.350		
ターンオン時間(抵抗負荷)	t_{on_R}	$I_C = 500\text{ A}, V_{CE} = 2000\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.62\text{ }\Omega, C_{GE} = 220\text{ nF}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.11			μs
ターンオンスイッチング損失	E_{on}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 1800\text{ V}, L_\sigma = 85\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.62\text{ }\Omega, C_{GE} = 220\text{ nF}, di/dt = 4300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		1400		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		1950		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		2200		

(続く)

表 4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ターンオフスイッチング損失	E_{off}	$I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$, $L_G = 85\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 2.4\ \Omega$, $C_{GE} = 220\text{ nF}$, $dv/dt =$ $2100\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1350		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	1800		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	1950		
短絡電流	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 2500\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 10\ \mu\text{s}$, $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	4800		A
ジャンクション・ケース間熱抵抗	R_{thJC}	IGBT 部 (1素子当り)			9.55	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thCH}	IGBT 部 (1素子当り), $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$			10.0	K/kW
動作温度	$T_{vj\ op}$			-40		150 °C

3 Diode、インバータ

表 5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位	
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}		$T_{vj} = -40\text{ }^\circ\text{C}$	3300	V
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	3300	
連続 DC 電流	I_F		1200	A	
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_p = 1\text{ ms}$	2400	A	
電流二乗時間積	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$, $V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	330	kA ² s
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	310	
最大損失	P_{RQM}	$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	1800	kW	
最小ターンオン時間	t_{onmin}		10	μs	

表 6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
順電圧	V_F	$I_F = 1200\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		3.25	3.95	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		2.90	3.35	
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		2.80		
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$V_R = 1800\text{ V}$, $I_F = 1200\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt =$ $4300\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1250		A	
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	1400			
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	1450			

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性

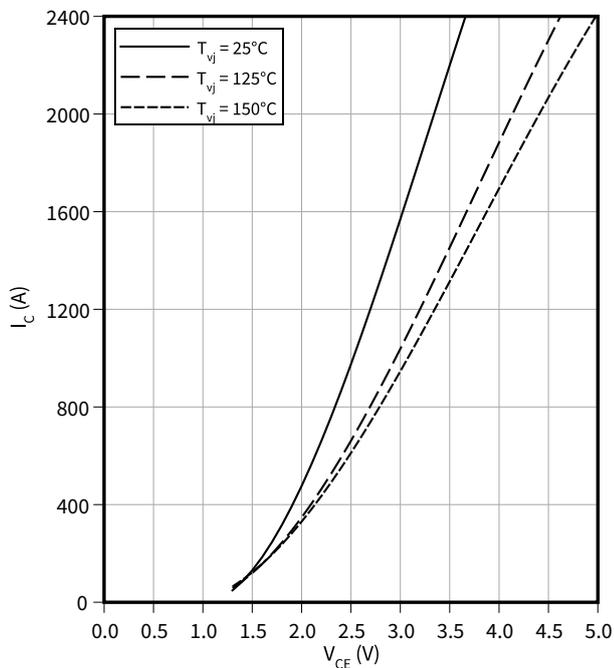
項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
逆回復電荷量	Q_r	$V_R = 1800 \text{ V}, I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 4300 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			μC
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		550	
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		1100	
逆回復損失	E_{rec}	$V_R = 1800 \text{ V}, I_F = 1200 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 4300 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		550	
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		1250	
ジャンクション・ケース間熱抵抗	R_{thJC}	/Diode(1素子当り)			17.0	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thCH}	/Diode(1素子当り), $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$			11.5	K/kW
動作温度	$T_{vj op}$		-40		150	$^\circ\text{C}$

4 特性図

出力特性 (Typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{CE})$

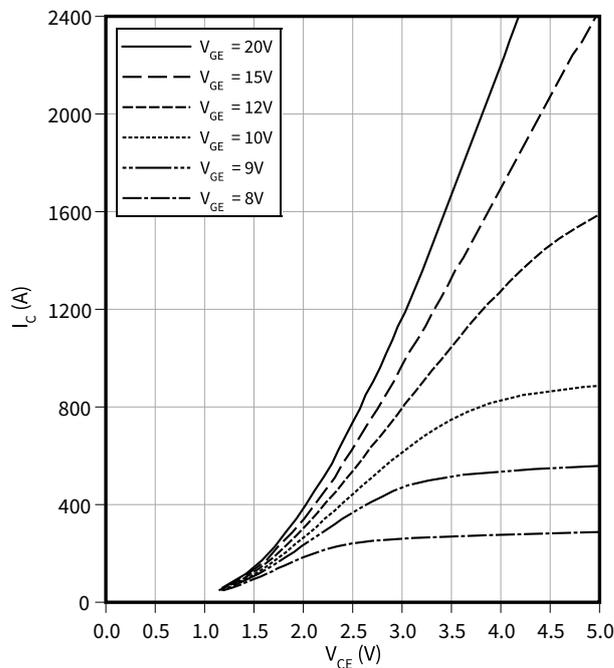
$V_{GE} = 15\text{ V}$



出力特性 (Typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{CE})$

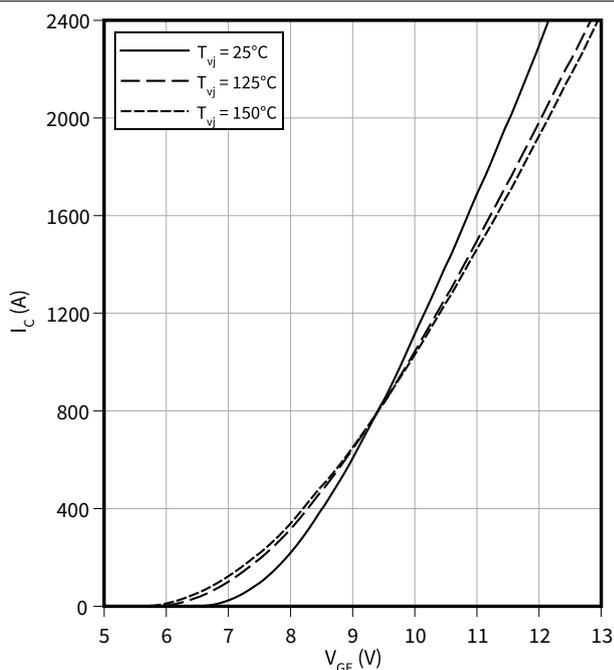
$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$



伝達特性 (Typical), IGBT- インバータ

$I_C = f(V_{GE})$

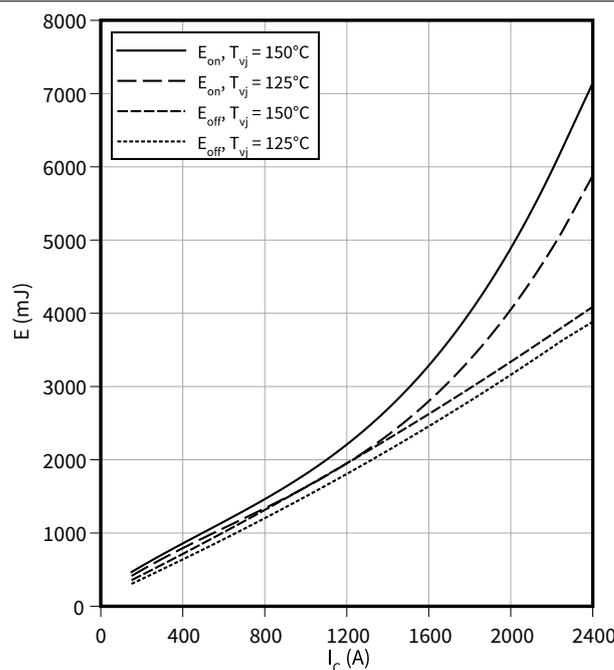
$V_{CE} = 20\text{ V}$



スイッチング損失 (Typical), IGBT- インバータ

$E = f(I_C)$

$R_{Goff} = 2.4\ \Omega, R_{Gon} = 0.62\ \Omega, C_{GE} = 220\text{ nF}, V_{CE} = 1800\text{ V}, V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$

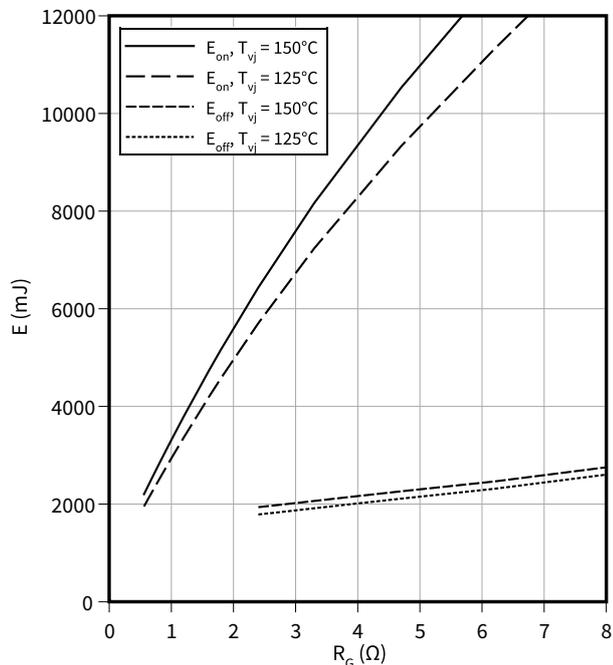


4 特性図

スイッチング損失 (Typical), IGBT- インバータ

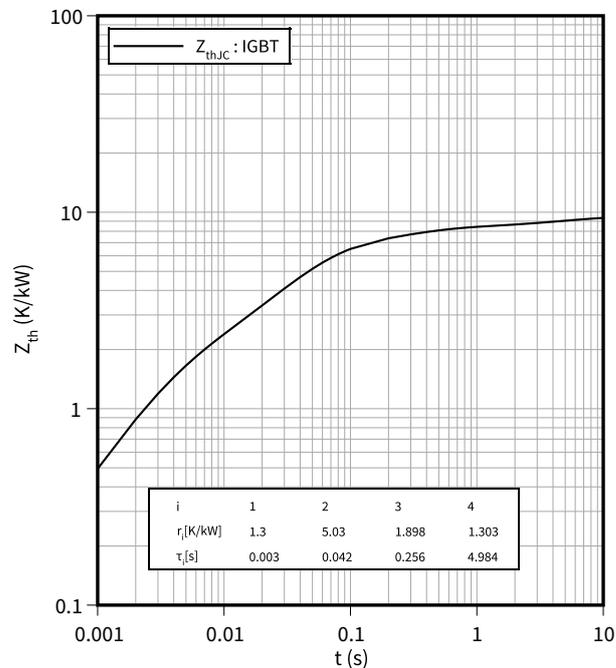
$E = f(R_G)$

$I_C = 1200 \text{ A}$, $C_{GE} = 220 \text{ nF}$, $V_{CE} = 1800 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 / 15 \text{ V}$



過渡熱インピーダンス, IGBT- インバータ

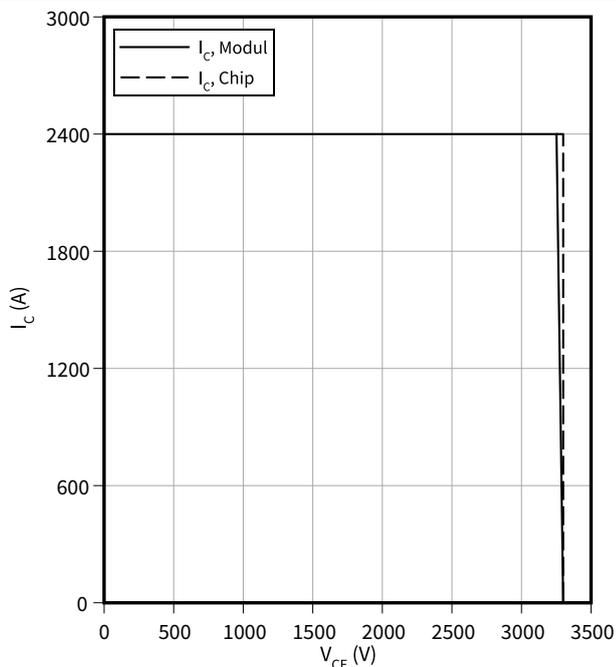
$Z_{th} = f(t)$



逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT- インバータ

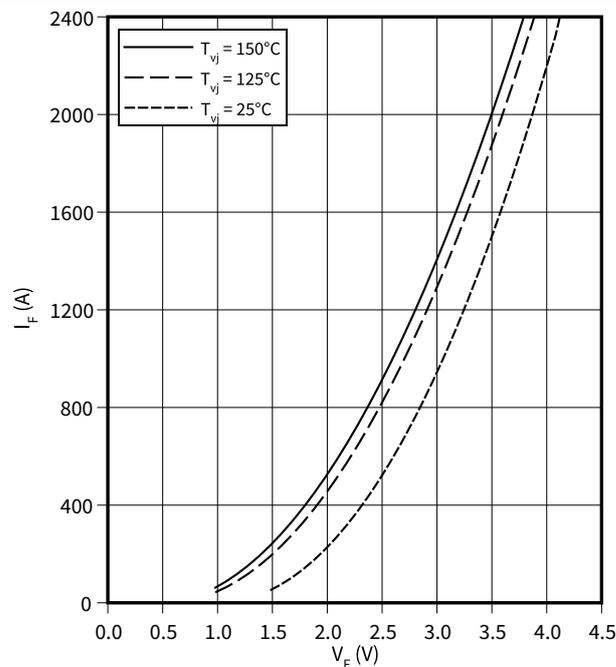
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 2.4 \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $C_{GE} = 220 \text{ nF}$, $T_{vj} = 150 \text{ °C}$



順電圧特性 (typical), Diode、インバータ

$I_F = f(V_F)$

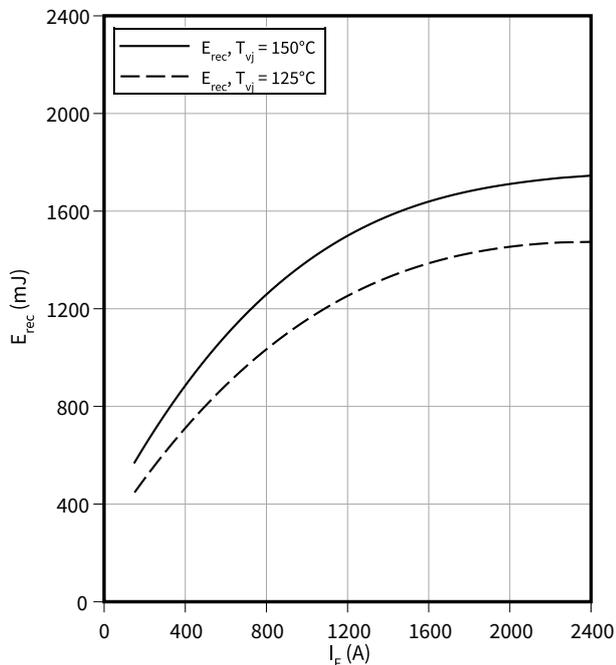


4 特性図

スイッチング損失 (Typical), Diode、インバータ

$$E_{rec} = f(I_F)$$

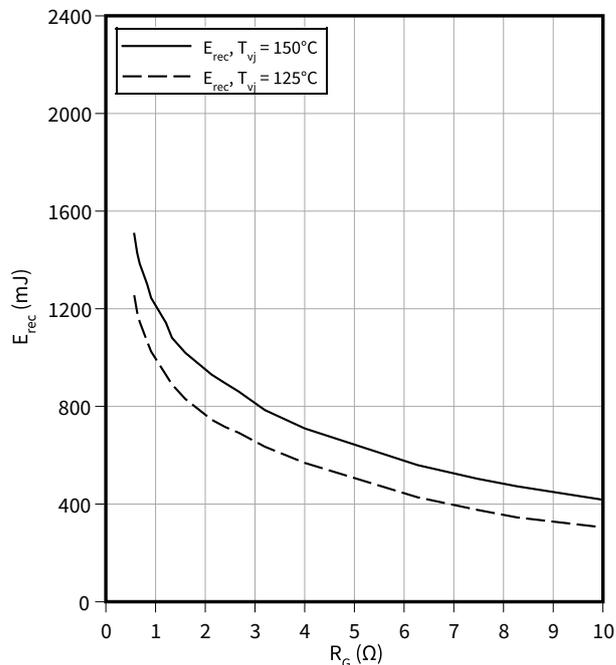
$V_{CE} = 1800 \text{ V}$, $R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$



スイッチング損失 (Typical), Diode、インバータ

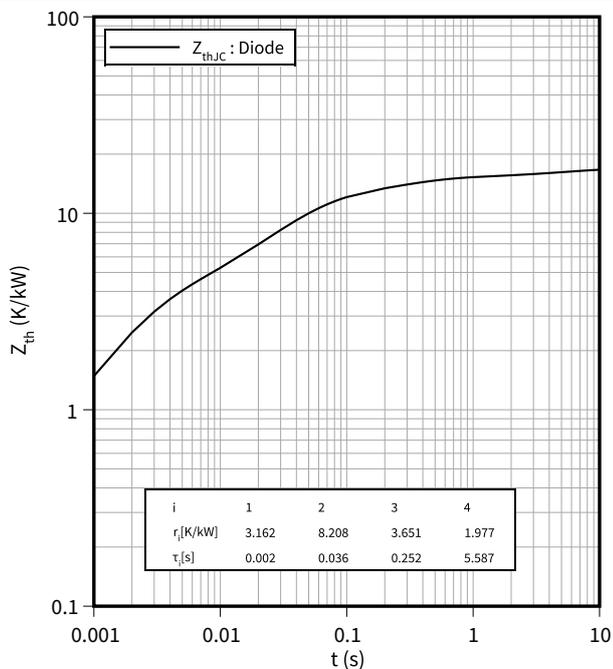
$$E_{rec} = f(R_G)$$

$V_{CE} = 1800 \text{ V}$, $I_F = 1200 \text{ A}$



過渡熱インピーダンス, Diode、インバータ

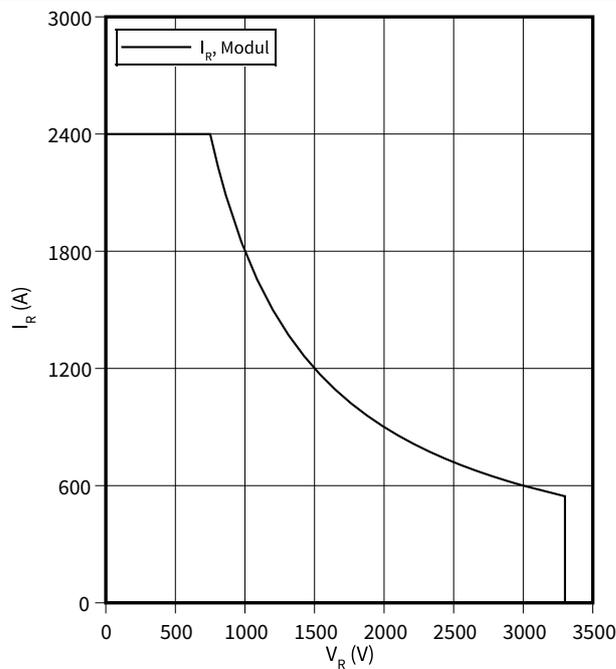
$$Z_{th} = f(t)$$



安全動作領域 (SOA), Diode、インバータ

$$I_R = f(V_R)$$

$T_{vj} = 150 \text{ °C}$



5 回路図

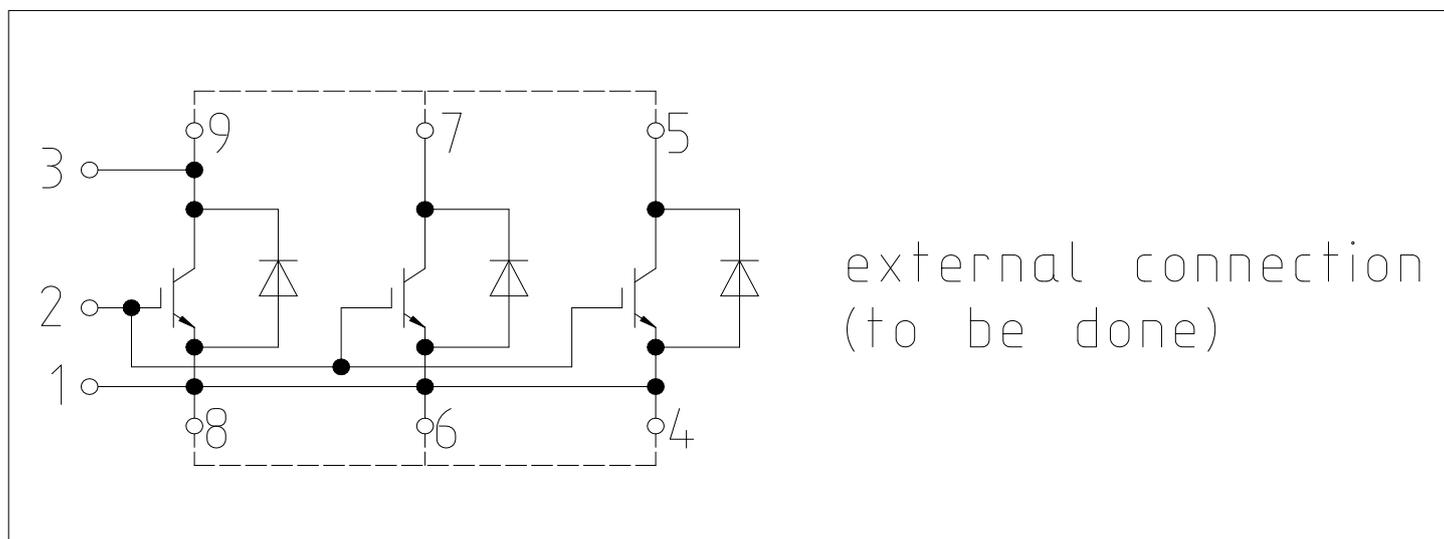


図 1

6 パッケージ外形図

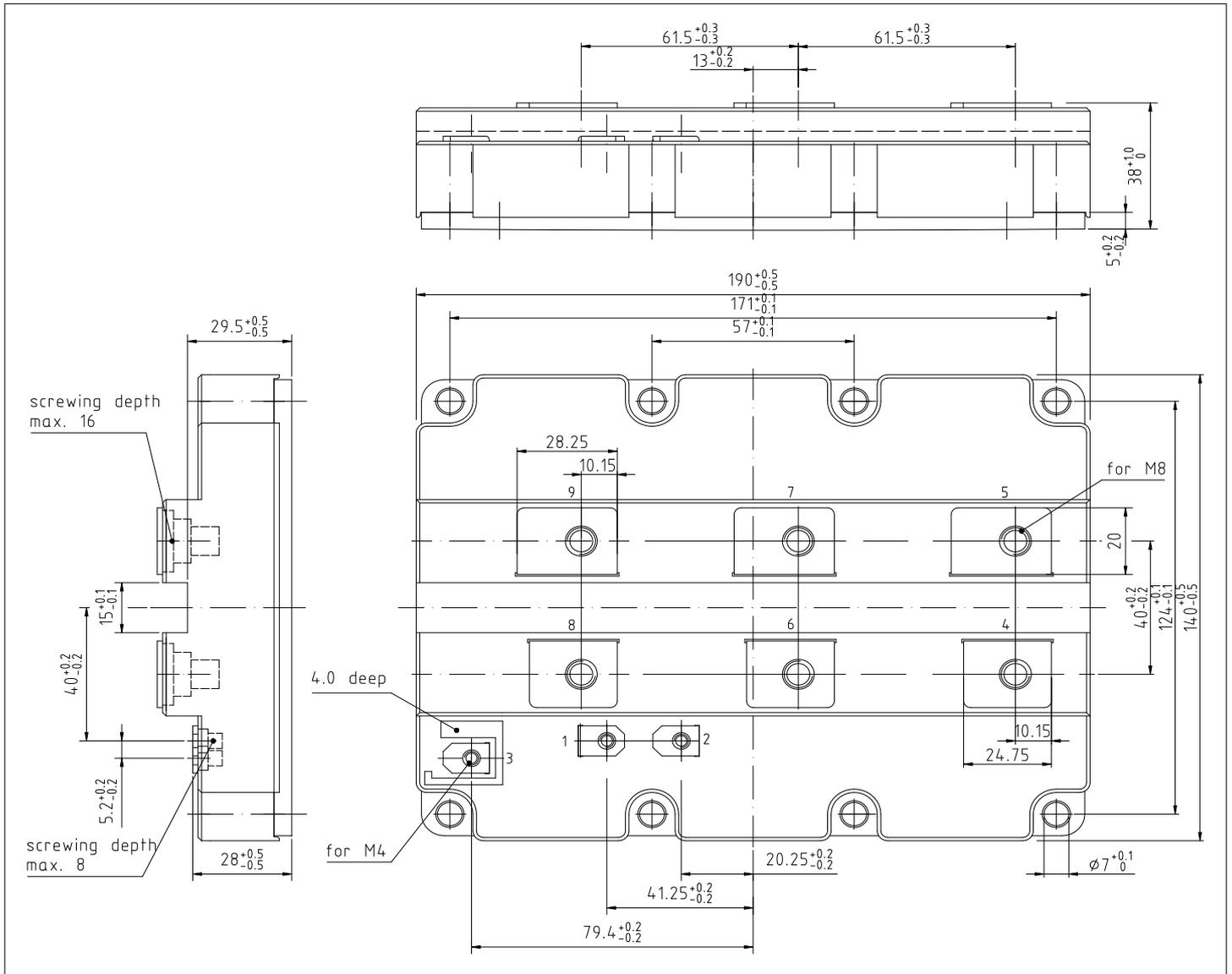


図 2

7 モジュールラベルコード

Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 - 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 - 21	15
	Date code (production week)	22 - 23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

図 3

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
V1.0	2009-09-15	Target datasheet
V2.0	2010-04-26	Preliminary datasheet
V2.1	2010-07-16	Preliminary datasheet
V3.0	2013-08-12	Final datasheet
V3.1	2013-12-11	Final datasheet
V3.2	2018-07-12	Final datasheet
V3.3	2019-07-24	Final datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.10	2021-10-29	Final datasheet